

Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Научно-информационный центр



**Васильев
Владислав Юрьевич**

ЮБИЛЕЙНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Книги, статьи и другие работы за 1976–2013 гг.

НОВОСИБИРСК
2013

ББК 91.9 : 72
В 296

Составители: *Н. А. Пусеп, Г. М. Ситишева*

Ответственные редакторы: *В. Н. Удотова, Т. В. Баздырева, Л. Б. Кистюнина*

Юбилейный указатель подготовлен Научной библиотекой НГТУ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Данный указатель составлен к юбилею доктора химических наук, профессора Васильева Владислава Юрьевича. В указатель вошли работы, информация о которых взята из библиографических указателей трудов преподавателей и сотрудников НЭТИ–НГТУ за 1983–1999 годы, из электронного каталога VIRTUA НБ НГТУ (1992–2013 гг.), Интернета, а также предоставлена самим автором.

Указатель содержит 159 библиографических записей на русском и иностранных языках за 1976–2013 годы, сгруппированных по видам публикаций:

- 1) научные публикации;
- 2) публикации о В. Ю. Васильеве.

Внутри разделов записи на русском и иностранных языках расположены в хронологическом порядке и имеют сплошную нумерацию.

Перечень разделов представлен в содержании.

Индекс цитирования представлен по БД Scopus.

Библиографический указатель составлен в соответствии с общепринятыми правилами и стандартами:

ГОСТ 7.80–2000. СИБИБД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления;

ГОСТ 7.82–2001. СИБИБД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;

ГОСТ 7.1–2003. СИБИБД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;

ГОСТ 7.11–2004. СИБИБД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках;

ГОСТ 7.12–2011. СИБИБД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила;

ГОСТ 7.23–96. СИБИБД. Издания информационные. Структура и оформление.

Описания публикаций, сведения о которых невозможно проверить, приведены со слов автора и имеют неполный характер. Данные описания имеют пометку *.

Справочный аппарат указателя включает:

- вводную часть: «От составителей», «Краткая биографическая справка»;
- именной указатель содержит фамилии, инициалы авторов (составителей, редакторов, научных руководителей) и ссылки на номера библиографических записей основного указателя. В квадратные скобки помещены номера записей публикаций, принадлежащих составителям, редакторам, научным руководителям;

- список источников информации;
- содержание.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Владислав Юрьевич Васильев родился в Саратове, где его родители окончили Саратовский государственный университет. В Новосибирске живет с трех лет, куда его отец Юрий Вячеславович после окончания физфака был направлен на работу в Научно-исследовательский институт измерительных приборов (НИИИП).

Интерес к предмету химии у Владислава Юрьевича появился еще в детстве, поскольку его мама Маргарита Николаевна преподавала химию в школе. В 1971 году В. Ю. Васильев окончил среднюю школу № 99 Новосибирска, в которой химию преподавала Альбина Николаевна Фаломкина. Под ее руководством группа учеников, и в их числе В. Ю. Васильев, участвовала в химических олимпиадах разного уровня, а затем обучалась в Летних школах Новосибирского государственного университета. Все это определило дальнейшее направление учебы В. Ю. Васильева, и после окончания школы он поступил на отделение химии факультета естественных наук НГУ.

Дипломный проект В. Ю. Васильева посвящен масс-спектрометрическому изучению взаимодействия окиси углерода с кислородом на монокристаллической платиновой фольге в условиях сверхвысокого вакуума. Руководитель дипломного проекта научный сотрудник института Института катализа СОАН СССР Владимир Филиппович Малахов оказал огромное влияние на формирование интереса студента Васильева к самостоятельной экспериментальной работе на сложной технике, к постановке тонких экспериментов, к анализу результатов и написанию первых научных статей.

После окончания НГУ в 1976 году В. Ю. Васильев был направлен инженером по распределению на Новосибирский завод полупроводниковых приборов в Особое конструкторское бюро (ОКБ при НЗПП). В химико-технологическом секторе № 6, которым руководила лауреат Государственной премии СССР Н. А. Эпова, Владислав сначала занимался вопросами исследования и устранения загрязнений в технологических средах, а затем начал работать в области тонких диэлектрических пленок.

С тех пор его судьба неразрывно связана с этим предприятием. Здесь он прошел путь от инженера до ведущего инженера, был руководителем группы, неоднократно назначался научным руководителем НИР и главным конструктором ОКР по разработке новых технологических процессов для производства интегральных микросхем. В 1985 году В. Ю. Васильев был назначен начальником сектора, спустя пять лет – начальником химико-технологического отдела и через некоторое время – главным инженером научно-производственного комплекса. В настоящее время В. Ю. Васильев работает в ОАО «НЗПП с ОКБ» в должности советника генерального директора по технологическим вопросам.

Под руководством и при непосредственном участии В. Ю. Васильева в ОКБ при НЗПП были разработаны и изготовлены установки получения тонких пленок при пониженном давлении на кремниевых пластинах диаметром 100 мм. В это время сформировалась основная область его интересов: технология изделий электроники, тонкопленочные покрытия, осаждение из газовой фазы, оборудование и методология получения тонких пленок, материаловедение, методы анализа тонкопленочных покрытий, применение тонких пленок в электронике.

В начале 1980-х годов появилась и крепла деловая и творческая связь с Новосибирским электротехническим институтом (в настоящее время – НГТУ), в котором под руководством

В. А. Гридчина велись работы по созданию действующих образцов прецизионных кремниевых сенсоров давления. Первые образцы таких сенсоров были использованы В. Ю. Васильевым при разработке технологических процессов осаждения тонких пленок из газовой фазы и дали возможность проводить точные измерения давления, калибровку манометрических ламп, а также количественно, с высокой точностью и достоверностью, характеризовать кинетику роста тонкопленочных покрытий. Возглавляемый им с 1985 года сектор тонких пленок ОКБ при НЗПП успешно разрабатывал и внедрял в производство различные процессы осаждения, в том числе плазменного осаждения, на установках собственной разработки. Во многом благодаря глубокой проработке вопросов оборудования и технология получения тонких пленок, разработанные и внедренные в производство в 1980-х годах, до сих пор функционируют на НЗПП. В это же время были написаны первые научные статьи, обзоры по технологии, получены первые авторские свидетельства.

В 1990 году без отрыва от основной работы Владислав Юрьевич Васильев защитил кандидатскую диссертацию по специальности 00.02.04 «Физическая химия» под руководством заведующего лабораторией Института физики полупроводников (ИФП) СОАН СССР, д-ра хим. наук, профессора С. М. Репинского. Работа была посвящена исследованию синтеза слоев нитрида и диоксида кремния осаждением из газовой фазы на основе хлорпроизводных моносилана; ее результаты были внедрены в серийное производство интегральных микросхем на НЗПП. В том же году В. Ю. Васильев был назначен на должность начальника химико-технологического отдела ОКБ при НЗПП.

В тяжелейшее время распада страны в 1990-х годах, ухода сотрудников большого и дружного коллектива отдела В. Ю. Васильев приложил много сил для сохранения отдела и объединения технологических линеек предприятия на базе ОКБ при НЗПП. Однако в связи с наступившей неопределенностью будущего в середине 1990-х годов Владислав Юрьевич принял сложное для себя решение временно попробовать продолжить работу по специальности за границей.

В 1995 году стало известно о наборе сотрудников в исследовательский отдел (R&D) вновь организованного в Сингапуре большого микроэлектронного предприятия Chartered Semiconductor Manufacturing, Ltd. (CSM, с 2010 года это предприятие входит в состав американской компании «Global Foundries Inc.»). Пройдя через «сито» отбора и собеседование и попав в число трех отобранных руководством CSM из более чем 30 русских специалистов-претендентов, в мае 1996 года В. Ю. Васильев начал работать в качестве старшего инженера в секторе тонких пленок в R&D CSM. Здесь он проработал до 2000 года в должности ведущего инженера. В итоге В. Ю. Васильев четыре года полностью посвятил экспериментальной работе в области технологий создания и исследования различных тонких пленок для субмикронных интегральных микросхем с проектно-технологическими нормами 0,35...0,15 мкм. Проводя эксперименты полностью самостоятельно практически все имеющееся время, иногда даже круглосуточно, он освоил все современные методы получения различных типов тонких пленок, оборудования, аналитическую технику и экспериментально проверил и развил идеи, сформулированные в кандидатской диссертации. В это время Владиславом Юрьевичем было написано много статей на английском языке, он выступал по приглашению на международных конференциях с докладами и лекциями, подал 7 заявок на патенты США.

В 1999 году в связи с планами руководства CSM по свертыванию программ исследовательских работ и реформированию отдела R&D в технологический отдел В. Ю. Васильев при-

нял решение о возвращении домой. В течение двух последующих лет после возвращения в августе 2000 года он занимался написанием докторской диссертации «Процессы химического осаждения из газовой фазы и свойства фосфор- и боросиликатных стеклообразных слоев» в докторантуре Института физики полупроводников СО РАН.

После защиты докторской диссертации по специальности 02.00.21 «Химия твердого тела» в Институте химии твердого тела СО РАН (научным консультантом выступил проф. С. М. Репинский), с 2002 по 2005 год В. Ю. Васильев работал по совместительству в качестве ведущего научного сотрудника ИФП. В этот период он опубликовал несколько обобщающих работ по результатам диссертационного исследования.

С 2003 года по приглашению заведующего кафедрой ППиМЭ НГТУ проф. В. А. Гридчина Владислав Юрьевич начал и по сегодняшний день продолжает вести занятия в НГТУ в должности профессора-совместителя по тематике технологии и производства изделий современной микроэлектроники. В 2005 году он был приглашен профессором-совместителем на кафедру технической электроники в Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, где также ведет занятия по технологии микронных устройств.

В рамках государственной программы Республики Корея «Brain Pool» В. Ю. Васильев был приглашен для выполнения перспективного научно-технического проекта «Исследования и разработка технологии осаждения сверхтонких слоев металлического рутения методами атомно-слоевого осаждения из газовой фазы для субмикронных интегральных микросхем с проектно-технологическими нормами 60–40 нм». Работы выполнялись им в должности приглашенного профессора в отделении нано-оптической инженерии в Корейском Политехническом университете, г. Шыхыннг, в 2006–2008 годах. Этот успешно завершенный проект позволил В. Ю. Васильеву издать несколько оригинальных публикаций в зарубежных и отечественных журналах, а также написать главу в монографию, изданную на английском языке.

С 2006 года и по настоящее время Владислав Юрьевич Васильев работает заместителем генерального директора вновь созданного дизайн-центра микроэлектронного проектирования ООО «СибИС» – первого в восточной части России дизайн-центра проектирования субмикронных интегральных микросхем и устройств на их основе.

В. Ю. Васильев – член научных обществ «The Electrochemical Society» и «American Nano Society», его биография включена в издание «Marquis Who's Who in Science and Engineering» (издания 2006–2011 годов), США.

Владислав Юрьевич Васильев – крупный специалист в области разработки технологических процессов изготовления микроэлектронных изделий; преподаватель Новосибирского государственного технического университета; автор большого количества научных публикаций и монографий; доктор химических наук; советник директора ОАО «НЗПП с ОКБ»; заместитель генерального директора известной компании в России в области проектирования микроэлектронных изделий ООО «СибИС», успешно совмещает научную, педагогическую и производственную виды деятельности.

Основной принцип жизнедеятельности Владислава Юрьевича – созидание, обязательное достижение поставленной цели на базе трудолюбия, увлеченности, творчества.

Цель и желание получить совершенный продукт относится не только к его профессиональной деятельности, но и к семейной, бытовой, творческой.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Книги, диссертации, авторефераты диссертаций

1. Васильев В. Ю. Синтез слоев нитрида и диоксида кремния осаждением из газовой фазы на основе хлорпроизводных моносилана : дис. ... канд. хим. наук / В. Ю. Васильев ; науч. рук. С. М. Репинский ; СОАН СССР, Институт химии твердого тела. – Новосибирск : Институт химии твердого тела СОАН СССР, 1990. – 182 с.
2. Васильев В. Ю. Процессы химического осаждения из газовой фазы и свойства фосфор- и боросиликатных стеклообразных слоев : дис. ... д-ра хим. наук / В. Ю. Васильев ; науч. консультант С. М. Репинский ; СО РАН, Институт химии твердого тела. – Новосибирск : Институт химии твердого тела СО РАН, 2002. – 386 с.
3. Vasilyev V. Y. Low-temperature thermally-activated pulsed chemical vapor deposition of ruthenium thin films using carbonyl-diene precursor / V. Y. Vasilyev // Ruthenium: properties, production and applications. – New York : Nova Science Publ., 2011. – P. 1–84. – (Chemical engineering methods and technology).
4. Vasilyev V. Y. Application of nitrous oxide for chemical vapor deposition of thin films used in integrated circuit technology / V. Y. Vasilyev // Advances in Chemistry Research. – New York : Nova Science Publ., 2013. – Vol. 19. – P. 55–84.
5. Vasilyev V. Y. Borophosphosilicate glass thin films in electronics / V. Y. Vasilyev. – New York : Nova Science Publ., 2013. – 243 p. – (Materials science and technologies).

Статьи из периодических изданий и научных сборников

6. Состояния хемосорбции и реакционная способность окиси углерода в отношении кислорода на платине / В. Ю. Васильев [и др.] // Нестационарные процессы в катализе : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : Институт катализа СО АН СССР, 1979. – С. 76–82.
7. Васильев В. Ю. Использование фильтрующих материалов ФП для фильтрации технологических жидкостей / В. Ю. Васильев, А. Л. Самородов // Электронная техника. – 1981. – Сер. 7, вып. 5. – С. 54–56.
8. Васильев В. Ю. Предварительная очистка технологических жидкостей фильтрами из материала ЛФС-2 / В. Ю. Васильев, Т. П. Кирпичникова // Электронная техника. – 1981. – Сер. 7, вып. 6. – С. 41–42.
9. Васильев В. Ю. Приспособление для контроля количества нерастворимых загрязнений в технологических жидкостях / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 1982. – Сер. 7, вып. 5. – С. 24–27.
10. Васильев В. Ю. Расчет времени непрерывной работы мембранных фильтров / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 1982. – Сер. 7, вып. 3. – С. 69.

11. Васильев В. Ю. Закономерности осаждения нитрида кремния при аммонолизе тетрахлорида кремния в реакторе низкого давления / В. Ю. Васильев, Л. Л. Васильева // Известия СОАН СССР. Сер. Химические науки. – 1983. – № 14, вып. 6. – С. 86–89.
12. Васильев В. Ю. Особенности осаждения слоев при пониженном давлении / В. Ю. Васильев // Электронная промышленность. – 1984. – Вып. 5. – С. 78–80.
13. Моделирование процессов осаждения диэлектрических слоев из газовой фазы при низком давлении / В. Ю. Васильев [и др.] // Обзоры по электронной технике. – 1984. – Сер. 2, вып. 8. – С. 1–25.
14. Васильев В. Ю. Аппаратура и методика осаждения слоев из газовой фазы при пониженном давлении. Ч. 1 / В. Ю. Васильев, М. С. Сухов // Обзоры по электронной технике. – 1985. – Сер. 7, вып. 3. – С. 1–46.
15. Васильев В. Ю. Аппаратура и методика осаждения слоев из газовой фазы при пониженном давлении. Ч. 2 / В. Ю. Васильев, М. С. Сухов // Обзоры по электронной технике. – 1985. – Сер. 7, вып. 4. – С. 1–52.
16. О влиянии параметров процесса осаждения при пониженном давлении на структуру слоев поликристаллического кремния / В. Ю. Васильев [и др.] // Полупроводниковые тензорезисторы : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НЭТИ, 1985. – С. 53–61.
17. Васильев В. Ю. Об осаждении слоев двуокиси кремния в системе диметилдихлорсилан- кислород при пониженном давлении / В. Ю. Васильев // Полупроводниковая тензометрия. Физические и технологические проблемы : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НЭТИ, 1986. – С. 70–77.
18. Васильев В. Ю. Оптимизация процесса осаждения слоев нитрида кремния / В. Ю. Васильев, С. М. Марошина // Электронная промышленность. – 1986. – Вып. 10. – С. 60–61.
19. Васильев В. Ю. Плазмохимическое осаждение тонких слоев в реакторах пониженного давления. Ч. 1 / В. Ю. Васильев, В. П. Попов, С. Н. Шепелев // Обзоры по электронной технике. – 1986. – Сер. 2, вып. 7. – С. 1–53.
20. Васильев В. Ю. Об осаждении слоев двуокиси кремния окислением моносилана закисью азота при пониженном давлении / В. Ю. Васильев, А. Н. Курченко // Полупроводниковая тензометрия : межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск : НЭТИ, 1988. – С. 11–22.
21. Васильев В. Ю. Оптимальный для технологии ИС состав слоев борофосфоросиликатного стекла / В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова // Электронная промышленность. – 1988. – Вып. 1. – С. 31.
22. Оценка степени планаризации рельефа ИС при оплавлении борофосфоросиликатного стекла / В. Ю. Васильев [и др.] // Электронная промышленность. – 1988. – Вып. 5. – С. 40–41.

23. Васильев В. Ю. Плазмохимическое осаждение тонких слоев в реакторах пониженного давления. Ч. 1 / В. Ю. Васильев, В. П. Попов, С. Н. Шепелев // *Обзоры по электронной технике*. – 1988. – Сер. 2, вып. 7. – С. 1–62.
24. Васильев В. Ю. Получение, свойства и применение слоев борофосфоросиликатного стекла в технологии ИС / В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова, Ю. И. Веретенин // *Обзоры по электронной технике*. – 1988. – Сер. 3, вып. 4. – С. 1–72.
25. Васильев В. Ю. Получение фосфорно-силикатных стекол в реакторах пониженного давления / В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова // *Электронная промышленность*. – 1988. – Вып. 3. – С. 51–54.
26. Васильев В. Ю. Выращивание слоя нитрида кремния с заданным профилем толщины на подложке / В. Ю. Васильев // *Электронная техника*. – 1989. – Сер. 2, вып. 6. – С. 88–89.
27. Васильев В. Ю. Закономерности роста слоев нитрида кремния в реакторах пониженного давления / В. Ю. Васильев, С. М. Марошина // *Полупроводниковая микроэлектроника*. – Новосибирск : НЭТИ, 1989. – С. 62–71.
28. Васильев В. Ю. Исследование взаимодействия дихлорсилана и аммиака в проточном реакторе низкого давления / В. Ю. Васильев, С. М. Марошина // *Известия АН СССР. Неорганические материалы*. – 1989. – Т. 25, № 4. – С. 600–604.
29. Васильев В. Ю. Модели и механизмы процессов осаждения тонких слоев из газовой фазы при пониженном давлении / В. Ю. Васильев // *Обзоры по электронной технике*. – 1990. – Сер. 2, вып. 3. – С. 1–56.
30. Плазмохимическое осаждение многослойных покрытий в едином технологическом цикле / В. Ю. Васильев [и др.] // *Электронная промышленность*. – 1990. – Вып. 12. – С. 67.
31. Васильев В. Ю. Исследование планаризации рельефа ИС при оплавлении борофосфоросиликатного стекла / В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова // *Электронная техника*. – 1991. – Сер. 3, вып. 4. – С. 38–41.
32. Васильев В. Ю. Аппаратура процессов осаждения слоев из газовой фазы / В. Ю. Васильев // *Химическая физика*. – 1992. – Т. 11, № 10. – С. 1406–1413.
33. Васильев В. Ю. Осаждение из газовой фазы и свойства слоев борофосфоросиликатного стекла / В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова // *Химическая физика*. – 1992. – Т. 11, № 12. – С. 1699–1710.
34. Васильев В. Ю. Взаимосвязь свойств слоев борофосфоросиликатного стекла с условиями их роста при химическом осаждении из газовой фазы / В. Ю. Васильев // *Журнал физической химии*. – 1999. – Т. 73, № 8. – С. 1351–1356.

35. Васильев В. Ю. Закономерности роста слоев борофосфоросиликатного стекла при химическом осаждении из газовой фазы / В. Ю. Васильев // Журнал физической химии. – 1999. – Т. 73, № 7. – С. 1191–1198.
36. Investigation of borophosphosilicate glass roughness and planarization with the atomic force microscope technique / V. Y. Vassiliev [et al.] // Thin Solid Films. – 1999. – Vol. 352, № 1–2. – P. 77–84.
37. Growth kinetics and deposition-related properties of subatmospheric pressure chemical vapor deposited borophosphosilicate glass film / V. Y. Vassiliev [et al.] // Journal of the Electrochemical Society. – 1999. – Vol. 146, iss. 8. – P. 3039–3051.
38. Vasil'ev V. Y. Factors governing growth of borophosphosilicate glass layers during chemical vapor deposition / V. Y. Vasil'ev // Russian Journal of Physical Chemistry. A. – 1999. – Vol. 73, № 7. – P. 1061–1067.
39. Vasil'ev V. Y. Interrelation between the properties of borophosphosilicate glass layers and the conditions of their growth during chemical vapor deposition / V. Y. Vasil'ev // Russian Journal of Physical Chemistry. A. – 1999. – Vol. 73, № 8. – P. 1205–1210.
40. Vasil'ev V. Y. Trends in CVD technology and equipment for obtaining thin insulating SiO₂-based films in microelectronics. Pt. 1. Materials, deposition methods, and equipment / V. Y. Vasil'ev // Russian Microelectronics. – 1999. – Vol. 28, iss. 3. – P. 146–152.
41. Vasil'ev V. Y. Trends in CVD technology and equipment for obtaining thin insulating SiO₂-based films in microelectronics. Pt. 2. Narrow gap fill / V. Y. Vasil'ev // Russian Microelectronics. – 1999. – Vol. 28, iss. 3. – P. 153–160.
42. Васильев В. Ю. О природе дефектов и механизме их формирования в тонких слоях борофосфоросиликатного стекла, получаемых осаждением из газовой фазы в процессе получения интегральных микросхем / В. Ю. Васильев // Физика и химия стекла. – 2000. – Т. 26, № 1. – С. 130–145.
43. Васильев В. Ю. Свойства осажденных из газовой фазы слоев борофосфоросиликатного стекла, используемых в технологии кремниевых интегральных микросхем / В. Ю. Васильев // Физика и химия стекла. – 2000. – Т. 26, № 1. – С. 116–129.
44. Vasil'ev V. Y. Properties of vapor-deposited borophosphosilicate glass layers employed in technology of silicon integrated circuits / V. Y. Vasil'ev // Glass Physics and Chemistry. – 2000. – Vol. 26, iss. 2. – P. 83–92.
45. Vasil'ev V. Y. On the nature of defects and mechanism of their formation in thin borophosphosilicate glass layers produced by vapor deposition upon fabrication of integrated circuits / V. Y. Vasil'ev // Glass Physics and Chemistry. – 2000. – Vol. 26, iss. 2. – P. 93–103.

46. Properties and gap-fill capability of HPD-CVD phosphosilicate glass films for subquarter-micrometer ULSI device technology / V. Y. Vassiliev [et al.] // *Electrochemical and Solid-State Letters*. – 2000. – Vol. 3, iss. 2. – P. 80–83.
47. Vassiliev V. Y. Trends in void-free pre-metal CVD dielectrics / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono, A. Cuthbertson // *Solid State Technology*. – 2001. – Vol. 44, iss. 3. – P. 129–136.
48. Васильев В. Ю. Заполнение ультрамалых зазоров в интегральных микросхемах осажденными из газовой фазы тонкими диэлектрическими материалами на основе диоксида кремния / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2002. – Т. 31, № 4. – С. 224–230.
49. Vassiliev V. Y. ULSI gap filling with a thin CVD SiO₂-based insulator: a review / V. Y. Vassiliev // *Russian Microelectronics*. – 2002. – Vol. 31, iss. 4. – P. 224–231.
50. Васильев В. Ю. Взаимосвязь параметров процессов осаждения из газовой фазы, свойств и строения тонких слоев борофосфоросиликатного стекла, используемых в технологии кремниевых интегральных микросхем / В. Ю. Васильев // *Физика и химия стекла*. – 2003. – Т. 29, № 5. – С. 640–653.
51. Васильев В. Ю. Процессы релаксации тонких слоев борофосфоросиликатных стекол при термически активированном вязком течении на ступенчатом рельефе интегральных микросхем. Ч. 1. Обобщение результатов исследований для изотермических и импульсных режимов нагрева слоев стекол / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2003. – Т. 32, № 3. – С. 163–176.
52. Васильев В. Ю. Процессы релаксации тонких слоев борофосфоросиликатных стекол при термически активированном вязком течении на ступенчатом рельефе интегральных микросхем. Ч. 2. Обобщенные параметры для характеристики процессов оплавления в ультрабольших интегральных микросхемах / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2003. – Т. 32, № 4. – С. 244–255.
53. Vasilev V. Y. Interrelation between the Parameters of Chemical Vapor Deposition, Properties, and Structure of Borophosphosilicate Glass Films Used in the Silicon Integrated Circuit Technology / V. Y. Vasilev // *Glass Physics and Chemistry*. – 2003. – Vol. 29, iss. 5. – P. 461–470.
54. Vasilyev V. Y. Low-temperature pulsed vapor-phase deposition of thin layers of metal ruthenium for micro- and nanoelectronics. Part 5. Interrelation of growth regularities, structure, and properties of ruthenium layers / V. Y. Vasilyev // *Russian Microelectronics*. – 2003. – Vol. 40, iss. 6. – P. 403–413.
55. Vasilyev V. Y. Low-temperature pulsed vapor-phase deposition of thin ruthenium metal layers for microelectronics and nanoelectronics. Part 4. The structure and basic properties of ruthenium layers / V. Y. Vasilyev // *Russian Microelectronics*. – 2003. – Vol. 40, iss. 4. – P. 279–288.
56. Vassiliev V. Y. Relationships between gas-phase film deposition, properties and structures of thin SiO₂ and BPSG films / V. Y. Vassiliev // *Journal of the Electrochemical Society*. – 2003. – Vol. 150, iss. 12. – P. F211–F218.

57. Vasilev V. Y. Thermally induced viscous flow of borophosphosilicate-glass thin films on stepped surfaces. Pt. 1. A review of quantitative studies on furnace and rapid thermal annealing / V. Y. Vasilev // *Russian Microelectronics*. – 2003. – Vol. 32, iss. 3. – P. 125–135.
58. Vasilev V. Y. Thermally induced viscous flow of borophosphosilicate-glass thin films on stepped surfaces. Pt. 2. Generalized parameters for ULSI glass flow characterization / V. Y. Vasilev // *Russian Microelectronics*. – 2003. – Vol. 32, iss. 4. – P. 190–199.
59. Васильев В. Ю. Тонкие слои борофосфоросиликатного стекла в технологии кремниевой микроэлектроники. Ч. 1. Осаждение из газовой фазы и свойства слоев стекла / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2004. – Т. 33, № 5. – С. 334–351.
60. Vasilev V. Y. Borophosphosilicate glass films in silicon microelectronics. Pt. 1. Chemical vapor deposition, composition, and properties / V. Y. Vasilev // *Russian Microelectronics*. – 2004. – Vol. 33, iss. 5. – P. 271–284.
61. Васильев В. Ю. Осаждение диэлектрических слоев из газовой фазы / В. Ю. Васильев, С. М. Репинский // *Успехи химии*. – 2005. – Т. 74, № 5. – С. 452–483.
62. Васильев В. Ю. Применение процессов химического осаждения из газовой фазы в технологии изготовления микросхем с технологическими нормами 0.35–0.18 мкм / В. Ю. Васильев // *Электронная промышленность*. – 2005. – Вып. 2. – С. 20–32.
63. Васильев В. Ю. Тонкие слои борофосфоросиликатного стекла в технологии кремниевой микроэлектроники. Ч. 2. Строение стекол и их применение в технологии / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2005. – Т. 34, № 2. – С. 83–97.
64. Vasilev V. Y. Borophosphosilicate glass films in silicon microelectronics. Pt. 2. Structure and applications / V. Y. Vasilev // *Russian Microelectronics*. – 2005. – Vol. 34, iss. 2. – P. 67–77.
65. Vasilev V. Y. Chemical vapour deposition of thin-film dielectrics / V. Y. Vasilev, S. M. Repinsky // *Russian Chemical Reviews*. – 2005. – Vol. 74, № 5. – P. 413–441.
66. Vasilyev V. Y. Quantifying ALD technologies for high aspect ratio structures / V. Y. Vasilyev, S.-H. Chung, Y. W. Song // *Solid State Technology*. – 2007. – Vol. 50, iss. 8. – P. 53–56.
67. Electrical and structural properties of ruthenium film grown by atomic layer deposition using liquid-phase $\text{Ru}(\text{CO})_3(\text{C}_6\text{H}_8)$ precursor / V. Y. Vasilyev [et al.] // *Materials Research Society Symposium – Proceedings*. – 2007. – Vol. 990. – P. 127–134.
68. Васильев В. Ю. Опыт выращивания нанослоев металлического рутения при низкотемпературном импульсном газофазном осаждении с участием карбонилдиенового прекурсора / В. Ю. Васильев // *Электроника Сибири. Микро- и наносистемная техника*. – 2008. – № 3. – С. 43–45.

69. Vasilyev V. Y. Nucleation and growth of pulsed CVD ru films from tricarbonyl [η^4 -cyclohexa-1.3-diene] ruthenium / V. Y. Vasilyev, K. P. Mogilnikov, Y. W. Song // *Journal of the Electrochemical Society*. – 2008. – Vol. 155, iss. 12. – P. D763–D770.
70. Vasilyev V. Y. Ruthenium film growth from $\text{Ru}(\text{CO})_3(\text{C}_6\text{H}_8)$ at low temperatures in sequentially pulsed deposition mode / V. Y. Vasilyev, S.-H. Chung, Y. W. Song // *Proceedings-Electrochemical Society*. – 2008. – Vol. 1. – P. 667–673.
71. Vasilyev V. Y. Surface selective growth of ruthenium films under low-temperature pulsed CVD conditions / V. Y. Vasilyev, K. P. Mogilnikov, Y. W. Song // *Electrochemical and Solid-State Letters*. – 2008. – Vol. 11, iss. 12. – P. D89–D93.
72. Vasilyev V. Y. Properties of thermally annealed ruthenium thin films grown on seed layers in a low-temperature selective deposition region / V. Yu. Vasilyev, K. P. Mogilnikov, Y. W. Song // *Current Applied Physics*. – 2009. – Vol. 9, iss. 2 (Suppl.). – P. E148–E151.
73. Васильев В. Ю. Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанозлектроники. Ч. 1. Оборудование и методология импульсного осаждения / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2010. – Т. 39, № 1. – С. 28–37.
74. Васильев В. Ю. Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанозлектроники. Ч. 2. Кинетика роста слоев рутения / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2010. – Т. 39, № 3. – С. 219–229.
75. Васильев В. Ю. Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанозлектроники. Ч. 3. Нуклеационные явления при росте слоев рутения / В. Ю. Васильев // *Микроэлектроника*. – 2010. – Т. 39, № 4. – С. 284–294.
76. Васильев В. Ю. Применение методов химического осаждения тонких слоев из газовой фазы для микросхем с технологическими нормами 0.35–0.18 мкм. Ч. 1. Основные тенденции развития методов / В. Ю. Васильев // *Электронная техника*. – 2010. – Сер. 2, вып. 1 (224). – С. 67–82.
77. Vasilyev V. Y. Low temperature pulsed gas-phase deposition of thin layers of metallic ruthenium for micro-and nanoelectronics. Pt. 2. Kinetics of the growth of ruthenium layers / V. Y. Vasilyev // *Russian Microelectronics*. – 2010. – Vol. 39, iss. 3. – P. 199–209.
78. Vasilyev V. Y. Low-temperature pulsed CVD of ruthenium thin films for micro- and nanoelectronic applications. Pt. 1. Equipment and methodology / V. Y. Vasilyev // *Russian Microelectronics*. – 2010. – Vol. 39, iss. 1. – P. 26–33.
79. Vasilyev V. Y. Low-temperature pulsed CVD of thin layers of metallic ruthenium for microelectronics and nanoelectronics. Pt. 3. Nucleation phenomena during the growth of ruthenium layers / V. Y. Vasilyev // *Russian Microelectronics*. – 2010. – Vol. 39, iss. 4. – P. 262–272.

80. Васильев В. Ю. Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанoeлектроники. Ч. 4. Структура и основные свойства слоев рутения / В. Ю. Васильев // Микроэлектроника. – 2011. – Т. 40, № 4. – С. 300–308.
81. Васильев В. Ю. Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанoeлектроники. Ч. 5. Взаимосвязь закономерностей роста, структуры и свойств слоев рутения / В. Ю. Васильев // Микроэлектроника. – 2011. – Т. 40, № 6. – С. 441–452.
82. Васильев В. Ю. Применение методов химического осаждения тонких слоев из газовой фазы для микросхем с технологическими нормами 0.35–0.18 мкм. Ч. 2. Аппаратура и методология осаждения слоев / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 2011. – Сер. 2, вып. 1 (226). – С. 51–66.
83. Васильев В. Ю. Применение методов химического осаждения тонких слоев из газовой фазы для микросхем с технологическими нормами 0.35–0.18 мкм. Ч. 3. Закономерности роста слоев в промышленных реакторах / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 2011. – Сер. 2, вып. 1 (227). – С. 24–36.
84. Проектирование сложно-функционального блока видеodeкодера для субмикронных интегральных микросхем типа «система на кристалле» / В. Ю. Васильев [и др.] // Успехи современной радиоэлектроники. Зарубежная радиоэлектроника. – 2011. – № 7. – С. 54–59.
85. Проектирование сложно-функциональных блоков смешанного сигнала на основе субмикронной технологии на примере микросхемы видеodeкодера. Ч. 2. Верификация микросхемы «на кремнии» / В. Ю. Васильев [и др.] // Вестник СибГУТИ. – 2011. – Вып. 3. – С. 3–13.
86. Проектирование сложно-функциональных блоков смешанного сигнала на основе субмикронной технологии на примере микросхемы видеodeкодера. Ч. 1. Конструкция и топология микросхемы / В. Ю. Васильев [и др.] // Вестник СибГУТИ. – 2011. – № 2. – С. 23–34.
87. Васильев В. Ю. Моделирование влияния конструктивно-технологических параметров на характеристики кремниевых резонансных сенсоров давления / В. Ю. Васильев, В. А. Гридчин, М. А. Чебанов // Известия вузов. Электроника. – 2012. – № 2 (94). – С. 61–66.
88. Васильев В. Ю. Применение методов химического осаждения тонких слоев из газовой фазы для микросхем с технологическими нормами 0.35–0.18 мкм. Ч. 5. Схемы роста и корреляция закономерностей осаждения и свойств тонких слоев / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 2012. – Сер. 2, вып. 2 (229). – С. 54–69.
89. Васильев В. Ю. Применение методов химического осаждения тонких слоев из газовой фазы для микросхем с технологическими нормами 0.35–0.18 мкм. Ч. 4. Обобщенная методология анализа закономерностей процессов роста тонких слоев / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 2012. – Сер. 2, вып. 1 (228). – С. 3–18.

90. Источник вторичного электропитания для радиоэлектронной аппаратуры, выполненный по технологии «мягкой» коммутации ключей / В. Ю. Васильев [и др.] // Успехи современной радиоэлектроники. – 2012. – № 11. – С. 63–70.
91. Разработка источников вторичного электропитания, реализованных с использованием технологии «мягкой» коммутации ключей. Ч. 1. Анализ информационных материалов и образцов источников питания / В. Ю. Васильев [и др.] // Вестник СибГУТИ. – 2012. – Вып. 3. – С. 85–96.
92. Васильев В. Ю. Влияние термических деформаций на температурную стабильность характеристик кремниевых резонансных сенсоров давления / В. Ю. Васильев, В. А. Гридчин, М. А. Чебанов // Нано- и микросистемная техника. – 2013. – № 3. – С. 41–44.
93. Васильев В. Ю. Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанoeлектроники. Ч. 6. Состав слоев рутения / В. Ю. Васильев // Микроэлектроника. – 2013. – Т. 42, № 1. – С. 62–75.
94. Васильев В. Ю. Низкотемпературное осаждение из газовой фазы при субатмосферном давлении слоев диоксида кремния окислением тетраэтоксисилана смесью озон-кислород для применения в субмикронных интегральных микросхемах. Ч. 1. Обзор состояния, направлений и задач исследования / В. Ю. Васильев // Электронная техника. – 2013. – Сер. 2, вып. 1 (230). – С. 76–87.
95. Разработка источников вторичного электропитания, реализованных с использованием технологии «мягкой» коммутации ключей. Ч. 2. Анализ схемотехнических решений источников питания / В. Ю. Васильев [и др.] // Вестник СибГУТИ. – 2013. – Вып. 1. – С. 75–84.
96. Разработка источников вторичного электропитания, реализованных с использованием технологии «мягкой» коммутации ключей. Ч. 3. Разработка макета силового модуля источника питания / В. Ю. Васильев [и др.] // Вестник СибГУТИ. – 2013. – № 2. – С. 75–85.

Информационные листы, депонированные рукописи

97. Фильтр для очистки воды от взвешенных частиц : информ. л. № 81–0654 / сост.: В. Ю. Васильев, А. Л. Самородов, В. И. Федорова. – Москва : ВИМИ, 1981. – * с.
98. Технологический процесс осаждения слоев фосфоросиликатного стекла при пониженном давлении с использованием малотоксичной легирующей примеси : информ. л. № 89–1917 / сост.: В. Ю. Васильев [и др.]. – Москва : ВИМИ, 1989. – * с.
99. Технология создания легкоплавкого диэлектрика на основе борофосфоросиликатного стекла : информ. л. № 89–1891 / сост.: В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова, С. М. Марошина. – Москва : ВИМИ, 1989. – * с.

Доклады, тезисы докладов на научных мероприятиях

100. Васильев В. Ю. Изучение взаимодействия окиси углерода с кислородом на платине / В.Ю. Васильев // Материалы 14 Всесоюзной студенческой конференции. – Новосибирск : НГУ, 1976. – С. 38–43.
101. Изучение отдельных этапов каталитического взаимодействия окиси азота и окиси углерода на платине. 1. Хемосорбция окиси азота / В. Ю. Васильев [и др.] // Материалы 3 Французско-Советского семинара по моделированию каталитических процессов и реакторов, Франция, Виллербан, 1976. – Виллербан, 1976. – С. 134–158.
102. Васильев В. Ю. Комплекс оборудования для осаждения диэлектрических и поликристаллических слоев при пониженном давлении / В. Ю. Васильев, Е. Е. Рябчикова, А. А. Шишкин // Тезисы докладов конференций. – Москва : ЦНИИ электроники, 1982. – Сер. 3, вып. 1. – С. 45–47.
103. Васильев В. Ю. Осаждение тонких слоев Si_3N_4 из SiCl_4 и NH_3 при пониженном давлении / В. Ю. Васильев // Тезисы докладов конференций. – Москва : ЦНИИ электроники, 1982. – Сер. 3, вып. 1. – С. 16–18.
104. Васильев В. Ю. Датчик малых давлений / В. Ю. Васильев, В. А. Гридчин, А. П. Лисофенко // Перспективы развития и применения методов тензометрии при исследовании прочности конструкций : тез. докл. 6 Всесоюз. семинара-совещ. – Фергана, 1983. – С. 23.
105. Васильев В. Ю. Исследование условий образования микрочастиц в газовой фазе при осаждении окисла в системе силан-закись азота при пониженном давлении / В. Ю. Васильев, А. Н. Курченко // Тезисы докладов конференций. – Москва : ЦНИИ электроники, 1984. – Сер. 6, вып. 1. – С. 25–27.
106. Васильев В. Ю. Кинетика осаждения слоев двуокиси кремния из газовой фазы при окислении моносилана закисью азота / В. Ю. Васильев, Л. Л. Васильева, С. М. Репинский // Тезисы докладов 1 Всесоюзного симпозиума по макроскопической кинетике и химической газодинамике. – Черноголовка, 1984. – С. 98–99.
107. Васильев В. Ю. Осаждение диэлектрических слоев из диметилдихлорсилана / В. Ю. Васильев, Н. М. Фоменко // Тезисы докладов конференций. – Москва : ЦНИИ электроники, 1984. – Сер. 6, вып. 1. – С. 33–34.
108. Vassiliev V. Y. A comparative study of TEOS-based chemical vapor deposition techniques for shallow trench isolation technology / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono, J.-Z. Zheng // ISIC-97 : 7 International symposium on IC technology, systems and applications, Singapore, 10–12 Sept. 1997 : proceedings. – NTU, 1997. – P. 597–600.
109. Characterization of surface defects in the sub-atmospheric pressure-CVD borophosphosilicate glass films on silicon wafer / V. Y. Vassiliev [et al.] // ISIC-97 : 7 intern. symp. on IC technol-

ogy, systems and applications, Hyatt Regency, Singapore, 10–12 Sept. 1997 : proceedings. – NTU, 1997. – P. 601–604.

110. Comparison of sub-atmospheric BPSG films with plasma enhanced BPSG films / V. Y. Vassiliev [et al.] // Third International Dielectrics for ULSI Multilevel Interconnection Conference (DUMIC) : [proceedings]. – VMIC, 1997. – P. 219–222.
111. The electrical properties of chemical vapor deposited silicon oxide films for applications as interlayer dielectrics in ULSI / V. Y. Vassiliev [et al.] // Conference on electrical insulation and dielectric phenomena : annual report, (CEIDP), Minnesota, USA, Oct. 1997. – [USA] : IEEE, 1997. – Vol. 1. – P. 150–153.
112. The formation and growth of surface defects in sub-atmospheric pressure BPSG films / V. Y. Vassiliev [et al.] // Third International Dielectrics for ULSI Multilevel Interconnection Conference (DUMIC) : [proceedings]. – VMIC, 1997. – P. 171–174.
113. The removal and suppression of surface defects in sub-atmospheric pressure BPSG films / V. Y. Vassiliev [et al.] // A specialty conference of 1997 multilevel VLSI interconnection conference (VMIC), US, Santa Clara, 13–14 Febr. 1997. – 1997. – P. 538.
114. Vassiliev V. Y. The analysis of optimized dopant concentration range in borophosphosilicate glass films for VLSI and ULSI / V. Y. Vassiliev, J.-Z. Zheng // Chemical Vapor Deposition : proc. of the fourteenth international conference and EUROCVI-11. – The Electrochem. Soc., 1997. – P. 1199–1204. – (Proc. ser. ; vol. 97, iss. 25).
115. Vassiliev V. Y. The investigation on the deposition kinetics of sub-atmospheric pressure glass film / V. Y. Vassiliev, J.-Z. Zheng // ISIC-97 : 7 intern. symp. on IC technology, systems and applications, Hyatt Regency, Singapore, 10–12 Sept. 1997 : proceedings. – NTU, 1997. – P. 522–525.
116. Vassiliev V. Y. Modern BPSG film technology (Invited lecture) / V. Y. Vassiliev // Short course on dielectrics for ulsi multilevel interconnection : visuals booklet. – [Santa Clara], 1998. – P. 113–194.
117. A comparative analysis of pre metal dielectric gap-fill capability for ULSI device technology / V. Y. Vassiliev [et al.] // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1999. – Vol. 8. – P. 186–189.
118. A study of properties and gap-fill capability of high-density plasma phosphosilicate glass films for ULSI technology / V. Y. Vassiliev [et al.] // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1999. – Vol. 8. – P. 561–564.
119. Evolution of defects in borophosphosilicate glass films / V. Y. Vassiliev [et al.] // 5 International dielectrics for ULSI multilevel interconnection conference (DUMIC) : proceedings. – Tampa : IMIC, 1999. – P. 139–148.

120. A highly manufacturable spacer profile solution for void-free PMD gap-fill in sub-0.25 micrometer technology / V. Vassiliev [et al.] // Plasma Processing 13 : proc. of the intern. symp. – The Electrochem. Soc., 2000 – Vol. 13. – P. 325–334.
121. Gap-fill capability of subatmospheric pressure chemically vapor deposited TEOS-ozone doped glass film annealed at low thermal budget conditions / V. Y. Vassiliev [et al.] // Sixth International Dielectrics for ULSI Multilevel Interconnection Conference (DUMIC) : [proceedings]. – The Centre, 2000. – P. 181–184.
122. Hydrogen concentration analysis in sequentially deposited thin films and application of surface charge analysis techniques for fast and non-destructive characterization of PECVD Silicon Nitride / V. Y. Vassiliev [et al.] // Proceedings of international VLSI/ULSI multilevel interconnection conference, US, Santa Clara, 2000. – Inst. Microelectronics Inter-On Chip Connection, 2000. – P. 411–413.
123. Improved PECVD pre-metal oxide liner deposition process with low residual charge non-uniformity in film to avoid excessive PID / V. Y. Vassiliev [et al.] // 5 International symposium on plasma process-induced damage, P2ID, Santa Clara, USA, May 2000. –California : AVS, 2000. – P. 38–41.
124. Properties of sub atmospheric pressure borophosphosilicate glass films annealed at low thermal budget conditions / V. Y. Vassiliev [et al.] // Sixth International Dielectrics for ULSI Multilevel Interconnection Conference (DUMIC) : [proceedings]. – The Centre, 2000. – P. 244–252.
125. Vassiliev V. Y. Kinetics and mechanism of CVD reactions of silicon-based thin films [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev // Meeting abstracts : the 197 meet. of The Electrochem. Soc., Canada, Toronto, 14–18 May 2000. – Philadelphia : Electrochem. Soc., 2000. – Mode of access: <http://www.electrochem.org/dl/ma/197/pdfs/0884.pdf>. – Title from screen.
126. Vassiliev V. Y. Void-free pre-metal gap-fill capability of CVD films for subquater micron ULSI (Invited presentation/paper) / V. Y. Vassiliev // Sixth International Dielectrics for ULSI Multilevel Interconnection Conference (DUMIC) : [proceedings]. – The Centre, 2000. – P. 121–132.
127. Low temperature ruthenium film atomic layer deposition from $\text{Ru}(\text{CO})_3(\text{C}_6\text{H}_8)$ and NH_3 using consecutive and separated gas pulses [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev [et al.] // Nano Korea 2007. – World Scientific Publishing, 2007. – 1 electron-optical disk (CD-ROM). – № PMA049. – Title with the label.
128. Vasilyev V. Y. Analysis of current progress and trends in development of Atomic Layer Deposition equipment and technology for microelectronic applications / V. Y. Vasilyev, S.-H. Chung, Y. W. Song // Nanostructures: physics and technology : proc. of the 15 intern. symp., Novosibirsk, Russia, 25–29 June 2007. – St. Petersburg, 2007. – P. 197–198.
129. Vasilyev V. Y. Comparison of Ruthenium films deposited from $\text{Ru}(\text{CO})_3(\text{C}_6\text{H}_8)$ in the presence of ammonia or nitrous oxide at low temperatures / V. Y. Vasilyev, S.-H. Chung, Y. W. Song //

Nano Korea 2007. – World Scientific Publishing, 2007. – 1 electron-optical disk (CD-ROM). – № PMA047. – Title with the label.

130. Vasilyev V. Y. Ruthenium film surface sensitivity and selectivity growth effects at low temperatures and pulsed chemical vapor deposition conditions / V. Y. Vasilyev, S.-H. Chung, Y. W. Song // The 1 international conference on microelectronics and plasma technology : (ICMAP 2008), Korea, Jeju, 18–20 Aug. 2008. – [Korea], 2008. – P. 6.
131. Vasilyev V. Y. Features of thin film CVD processes used in IC device technology / V. Y. Vasilyev // 10 International conference and seminar on micro/nanotechnologies and electron devices proceedings : proc. EDM'2009, Erlagol, Altai, 1–6 July 2009. – Novosibirsk, 2009. – P. 104–111.
132. Vasilyev V. Y. Ruthenium thin film growth under low temperature pulsed CVD conditions using carbonyl-diene precursor / V. Y. Vasilyev // International school and seminar on modern problems of nanoelectronics, micro- and nanosystem technologies, 2009. INTERNANO 2009. – Novosibirsk, 2009. – P. 78–80.
133. Vasilyev V. Y. Equipment and methodology aspects of nano-thick film growth by consecutive gas pulsed chemical vapor deposition technique at low temperatures / V. Y. Vasilyev, Y. W. Song // 11 International conference and seminar on micro/nanotechnologies and electron devices : proc. EDM'2010, Altai, Erlagol, 30 June – 4 July, 2010. – Novosibirsk, 2010. – P. 9–17.
134. Васильев В. Ю. Разработка процессов CVD для современных электронных технологий / В. Ю. Васильев // 2 семинар по проблемам химического осаждения из газовой фазы : сб. тез. докл. – Новосибирск : ИНХ СО РАН, 2011. – С. 60.
135. Васильев В. Ю. Коррекция субмикронных многоуровневых интегральных микросхем с помощью электронно-ионного микроскопа / В. Ю. Васильев, М. В. Топякова, А. А. Величко // Электронная техника и технологии : сб. тр. междунар. науч. конф. – Харьков, 2012. – Т. 2. – С. 42.
136. Васильев В. Ю. Низкотемпературное осаждение слоев диоксида кремния в условиях субатмосферного давления окислением тетраэтоксисилана смесью озон-кислород при последовательно-импульсном напуске реагентов / В. Ю. Васильев // 3 семинар по проблемам химического осаждения из газовой фазы : программа и сб. тез. докл. – Иркутск, 2013. – С. 50–51.

Авторские свидетельства, патенты

137. А. с. 892153 СССР, МКИ F 25 J 5/00 ; В 01 D 46/10. Фильтр для очистки газов / В. И. Филиппьев, М. С. Сухов, В. Ю. Васильев. – № 2905544/23–26 ; заявл. 04.04.80 ; опубл. 23.12.81, Бюл. № 47. – * с.
138. А. с. 1122166 СССР не подлежит публикации.

139. А. с. 1190867 СССР не подлежит публикации.
140. А. с. 1203046 СССР, МКИ 4 С 03 ; С 17/02. Способ получения пленок фосфоросиликатного стекла / В. Ю. Васильев, Т. Г. Духанова. – № 3654957/29–33 ; заявл. 29.07.84 ; опубл. 07.01.86, Бюл. № 1. – * с.
141. А. с. 1415670 СССР не подлежит публикации.
142. А. с. 1565061 СССР не подлежит публикации.
143. А. с. 242525 СССР не подлежит публикации.
144. Пат. 2059323 РФ, МПК Н 01 L 21/316. Композиция для получения пленок фосфоросиликатного стекла на полупроводниковых подложках [Электронный ресурс] / В. Ю. Васильев [и др.]. – № 93025311/25 ; заявл. 27.04.1993 ; опубл. 27.04.1996. – Режим доступа: <http://www.findpatent.ru/patent/205/2059323.html>. – Загл. с экрана.
145. Pat. 5876798 A US. Method of fluorinated silicon oxide film deposition [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev. – № 08/998,634 ; fild 29.12.1997 ; publ. 02.03.1999. – Mode of access: <http://www.google.com/patents/US5876798>. – Title from screen.
146. Pat. 6027982 A US. Guang. Method to form shallow trench isolation structures with improved isolation fill and surface planarity [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev [et al.] – № 09/245,565 ; fild 5.02.1999 ; publ. 22.02.2000. – Mode of access: <https://www.google.com/patents/US6027982>. – Title from screen.
147. Pat. 6180490 B1 US. Method of Shallow Trench Filling Improvement [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev, I. Peidous. – № 09/318,670 ; fild 25.05.1999 ; publ. 30.01.2001. – Mode of access: <https://www.google.com/patents/US6027982>. – Title from screen.
148. Pat. 6197705 B1 US. Method of silicon oxide and silicon glass films deposition [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev. – № 09/270,598 ; fild 18.03.1999 ; publ. 06.03.2001. – Mode of access: <http://www.google.com/patents/US6197705>. – Title from screen.
149. Pat. 6355581 B1 US. Gas-phase additives for an enhancement of lateral etch component during HDP film deposition to improve film gap-fill capability [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev [et al.] – № 09/511,276 ; fild 23.02.2000 ; publ. 12.03.2002. – Mode of access: <http://www.google.co.in/patents/US6355581>. – Title from screen.
150. Pat. 6500771 B1 US. Method of high-density plasma boron-containing silicate glass film deposition [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono, A. Cuthbertson. – № 09/494,635 ; fild 31.01.2000 ; publ. 31.12.2002. – Mode of access: <http://www.google.co.in/patents/US6500771>. – Title from screen.
151. [Pat. 171627 Taiwan. Method of silicon oxide and silicon glass film deposition (Pat. 6583069 US) / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono. – № 09270558590 ; publ. 21.01.2003. – * p.]

152. Pat. 6583069 B1 US Method of silicon oxide and silicon glass film deposition [Electronic resource] / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono. – № 09/458,729 ; filed 13.12.1999 ; publ. 24.06.2003. – Mode of access: <http://www.google.co.in/patents/US6500771>. – Title from screen.

Отчеты о НИР

153. Разработка и освоение в опытном производстве технологии и оборудования получения диэлектрических слоев и поликремния, обеспечивающих серийный выпуск ЗУ : отчет об ОКР / ОКБ НЗПП ; гл. конструктор ОКР В. Ю. Васильев. – Новосибирск, 1982. – 234 с. – № ГР *. – Инв. № 325.
154. Исследование возможности разработки технологического процесса осаждения слоев фосфоросиликатных стекол в реакторе пониженного давления : отчет о НИР / ОКБ НЗПП ; науч. рук. В. Ю. Васильев – Новосибирск, 1983. – 140 с. – № ГР У87260 – Инв. № 335.
155. Разработка технологии осаждения диэлектрических слоев и поликремния с разбросом толщины $\pm 5\%$ на пластинах кремния диаметром 100 мм : отчет об ОКР / ОКБ НЗПП ; гл. конструктор ОКР В. Ю. Васильев. – Новосибирск, 1984. – 77 с. – № ГР У97300. – Инв. № 353 В.
156. Разработка технологии осаждения межслойной изоляции для поликремния : отчет об ОКР / Новосибирск. – ОКБ НЗПП ; гл. конструктор ОКР В. Ю. Васильев. – Новосибирск, 1985. – 153 с. – № ГР У11432. – Инв. № 381.
157. Исследование механизма образования дефектов при осаждении диэлектрических и полупроводниковых слоев в РПД : отчет о НИР / Новосибирск. – ОКБ НЗПП ; науч. рук. В. Ю. Васильев. – Новосибирск, 1987. – 50 с. – № ГР У28829. – Инв. № 445.
158. Разработка технологии получения борофосфоросиликатного стекла, Новосибирск : отчет об ОКР / Новосибирск. – ОКБ НЗПП ; гл. конструктор ОКР В. Ю. Васильев. – Новосибирск, 1987. – 152 с. – № ГР У28830. – Инв. № 443.

ПУБЛИКАЦИИ О В. Ю. ВАСИЛЬЕВЕ

159. Васильев Владислав Юрьевич [Электронный ресурс] : [краткая биограф. справка] // Ученые России : энциклопедия : биограф. данные и фото 13 682 выдающихся ученых и специалистов. – Режим доступа : <http://famous-scientists.ru/10120>. – Загл. с экрана

ЦИТИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В. Ю. ВАСИЛЬЕВА

Цитирование по БД Scopus

Проведен поиск по мировой библиографической базе данных Scopus. Поиск выявил следующие ссылки на публикации В. Ю. Васильева, цитируемые в период 1997–2013 гг.

| Публикации В. Ю. Васильева | Число цитирований данной статьи |
|---|---------------------------------|
| 1. Characterization of surface defects in the sub atmospheric pressure-CVD borophosphosilicate glass film on silicon wafer / V. Y. Vassiliev [et al.] // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1997. – Vol. 7. – P. 601–604. | 2 |
| 2. Electrical and structural properties of ruthenium film grown by atomic layer deposition using liquid-phase Ru(CO) ₃ (C ₆ H ₈) precursor / V. Y. Vassilyev [et al.] // Materials Research Society Symposium Proceedings. – 2007. – Vol. 990. – P. 127–134. | 3 |
| 3. Growth kinetics and deposition-related properties of subatmospheric pressure chemical vapor deposited borophosphosilicate glass film / V. Y. Vassiliev [et al.] // Journal of the Electrochemical Society. – 1999. – Vol. 146, iss. 8. – P. 3039–3051. | 16 |
| 4. Improved PECVD pre-metal oxide liner deposition process with low residual charge non-uniformity in film to avoid excessive PID / V. Y. Vassiliev [et al.] // 5 International symposium on plasma process-induced damage, P2ID, Santa Clara, USA, May 2000. – California : AVS, 2000. – P. 38–41. | 1 |
| 5. Investigation of borophosphosilicate glass roughness and planarization with the atomic force microscope technique / V. Y. Vassiliev [et al.] // Thin Solid Films. – 1999. – Vol. 352, iss. 1–2. – P. 77–84. | 10 |
| 6. Properties and gap-fill capability of HPD-CVD phosphosilicate glass films for subquarter-micrometer ULSI device technology / Vassiliev [et al.] // Electrochemical and Solid-State Letters. – 2000. – Vol. 3, iss. 2. – P. 80–83. | 9 |
| 7. The electrical properties of chemical vapor deposited silicon oxide films for applications as interlayer dielectrics in ULSI / V. Y. Vassiliev [et al.] // Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), Annual Report. – 1997. – Vol. 1. – P. 150–153. | 1 |

| | |
|--|---|
| 8. Vasilev V. Y. Borophosphosilicate glass films in silicon microelectronics. Pt. 1: Chemical vapor deposition, composition, and properties / V. Y. Vasilev // Russian Microelectronics. – 2004. – Vol. 33, iss. 5. – P. 271–284. | 1 |
| 9. [Vasilev V. Y. Borophosphosilicate glass films in silicon microelectronics. Pt. 1: Chemical vapor deposition, composition, and properties / V. Y. Vasilev // Mikroelektronika. – 2004. – Vol. 33, iss. 5. – P. 334–351.] | 2 |
| 10. Vasilev V. Y. Thermally induced viscous flow of borophosphosilicate-glass thin films on stepped surfaces. Pt. 1: A review of quantitative studies on furnace and rapid thermal annealing / V. Y. Vasilev // Russian Microelectronics. – 2003. – Vol. 32, iss. 3. – P. 125–135. | 3 |
| 11. Vasilev V. Y. Chemical vapour deposition of thin-film dielectrics / V. Y. Vasilev, S. M. Repinsky // Russian Chemical Reviews. – 2005. – Vol. 74, iss. 5. – P. 413–441. | 2 |
| 12. [Vasil'ev V. Y. Thermally induced viscous flow of borophosphosilicate-glass thin films and stepped chip surfaces, part 1: A review of quantitative studies on furnace and rapid thermal annealing / V. Y. Vasil'ev // Mikroelektronika. – 2003. – Vol. 32, iss. 3. – P. 163–177.] | 1 |
| 13. Vasil'ev V. Y. Trends in CVD Technology and Equipment for Obtaining Thin Insulating SiO ₂ -Based Films in Microelectronics. Part 1: Materials, Deposition Methods, and Equipment / V. Y. Vasil'ev // Russian Microelectronics. – 1999. – Vol. 28, iss. 3. – P. 146–152. | 4 |
| 14. Vasil'ev V. Y. Trends in CVD Technology and Equipment for Obtaining Thin Insulating SiO ₂ -Based Films in Microelectronics. Part 2: Narrow Gap Fill / V. Y. Vasil'ev // Russian Microelectronics. – 1999. – Vol. 28, iss. 3. – P. 153–160. | 5 |
| 15. Vasilyev V. Y. Low temperature pulsed gas-phase deposition of thin layers of metallic ruthenium for micro- and nanoelectronics: Pt 2. kinetics of the growth of ruthenium layers / V. Y. Vasilyev // Russian Microelectronics. – 2010. – Vol. 39, iss. 3. – P. 199–209. | 1 |
| 16. Vasilyev V. Y. Low-temperature pulsed CVD of ruthenium thin films for micro- and nanoelectronic applications. Part 1: Equipment and methodology / V. Y. Vasilyev // Russian Microelectronics. – 2010. – Vol. 39, iss. 1. – P. 26–33. | 1 |
| 17. Vasilyev V. Y. Low-temperature pulsed CVD of thin layers of metallic ruthenium for microelectronics and nanoelectronics. Part 3: Nucleation phenomena during the growth of ruthenium layers / V. Y. Vasilyev // Russian Microelectronics. – 2010. – Vol. 39, iss. 4. – P. 262–272. | 3 |

| | |
|--|---|
| 18. Vasilyev V. Y. Nucleation and growth of pulsed CVD ru films from tricarbonyl [η^4 -cyclohexa-1,3-diene]ruthenium / V. Y. Vasilyev, K. P. Mogilnikov, Y. W. Song // Journal of the Electrochemical Society. – 2008. – Vol. 155, iss. 12. – P. D763–D770. | 5 |
| 19. Vasilyev V. Y. Properties of thermally annealed ruthenium thin films grown on seed layers in a low-temperature selective deposition region / V. Yu. Vasilyev, K. P. Mogilnikov, Y. W. Song // Current Applied Physics. – 2009. – Vol. 9, iss. 2 (Suppl.). – P. E148–E151. | 3 |
| 20. Vasilyev V. Y. Quantifying ALD technologies for high aspect ratio structures / V. Y. Vasilyev, S.-H. Chung, Y. W. Song // Solid State Technology. – 2007. – Vol. 50, iss. 8. – P. 53–56. | 3 |
| 21. Vasilyev V. Y. Ruthenium film growth from Ru (CO) ₃ (C ₆ H ₈) at low temperatures in sequentially pulsed deposition mode / V. Y. Vasilyev, S. H. Chung, Y. W. Song // Proceedings-Electrochemical Society. – 2008. – Vol. 1. – P. 667–673. | 1 |
| 22. Vasilyev V. Y. Surface selective growth of ruthenium films under low-temperature pulsed CVD conditions / V. Y. Vasilyev, K. P. Mogilnikov, Y. W. Song // Electrochemical and Solid-State Letters. – 2008. – Vol. 11, iss. 12. – P. D89–D93. | 6 |
| 23. Vassiliev V. Y. A comparative study of TEOS-based chemical vapor deposition techniques for shallow trench isolation technology / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono, J.-Z. Zheng // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1997. – Vol. 7. – P. 597–600. | 1 |
| 24. Vassiliev V. Y. The investigation on the deposition kinetics of sub-atmospheric pressure glass film / V. Y. Vassiliev, J.-Z. Zheng // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1997. – Vol. 7. – P. 522–525. | 3 |
| 25. Vassiliev V. Y. A comparative analysis of pre metal dielectric gap-fill capability for ULSI device technology / V. Y. Vassiliev [et al.] // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1999. – Vol. 8. – P. 186–189. | 2 |
| 26. Vassiliev V. Y. A study of properties and gap-fill capability of high-density plasma phosphosilicate glass films for ULSI technology / V. Y. Vassiliev [et al.] // International Symposium on IC Technology, Systems and Applications. – 1999. – Vol. 8. – P. 561–564. | 1 |

| | |
|--|-----------|
| <p>27. Vassiliev V. Y. Relationships between gas-phase film deposition, properties and structures of thin SiO₂ and BPSG films / V. Y. Vassiliev // Journal of the Electrochemical Society. – 2003. – Vol. 150, iss. 12. – P. F211–F218.</p> | <p>6</p> |
| <p>28. Vassiliev V. Y. Trends in void-free pre-metal CVD dielectrics / V. Y. Vassiliev, J. L. Sudijono, A. Cuthbertson // Solid State Technology. – 2001. – Vol. 44, iss. 3. – P. 129–136.</p> | <p>12</p> |
| <p>29. Vassiliev V. Y. ULSI Gap Filling with a Thin CVD SiO₂-Based Insulator: A Review / V. Y. Vassiliev // Russian Microelectronics. – 2002. – Vol. 31, iss. 4. – P. 224–231.</p> | <p>3</p> |

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В

Васильева Л. Л. 11, 106
Величко А. А. 135
Веретенин Ю. И. 24

Г

Гридчин В. А. 87, 92, 104

Д

Духанова Т. Г. 21, 24, 25, 31, 33, [99], 140

К

Кирпичникова Т. П. 8
Курченко А. Н. 20, 105

Л

Лисофенко А. П. 104

М

Марошина С. М. 18, 27, 28, [99]

П

Попов В. П. 19, 23

Р

Репинский С. М. [1], [2], 61, 106
Рябчикова Е. Е. 102

С

Самородов А. Л. 7, [97]
Сухов М. С. 14, 15, 137

Т

Топякова М. В. 135

Ф

Федорова В. И. [97]
Филипьев В. И. 137
Фоменко Н. М. 107

Ч

Чебанов М. А. 87, 92

Ш

Шепелев С. Н. 19, 23
Шишкин А. А. 102

С

Chung S. H. 70
Chung S.-H. 66, 128, 129, 130
Cuthbertson A. 47, 150

М

Mogilnikov K. P. 69, 71, 72

Р

Peidous I. 147

Р

Repinsky S. M. 65

С

Song Y. W. 66, 69, 70, 71, 72, 128, 130, 133
Song Y.W. 129
Sudijono J. L. 47, 108, 150, 151, 152

Z

Zheng J.-Z. 108, 114, 115

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Алфавитный каталог НБ НГТУ.
2. Вузы Новосибирска [Электронный ресурс] : библиогр. база данных ст. из период. изд. о вузах Новосибирска / Науч. б-ка НГТУ. – Электрон. данные (4506 записей). – Новосибирск, 1998–2012.
3. Библиография НБО [Электронный ресурс] : библиогр. база данных ст. из период. изд. фонда Науч. б-ки НГТУ / Науч. б-ка НГТУ. – Электрон. данные (17 266 записей). – Новосибирск, 1999–2005.
4. Образование [Электронный ресурс] : библиогр. база данных ст. период. изд., науч. сб. о высшем образовании / Науч. б-ка НГТУ. – Электрон. данные (7891 запись). – Новосибирск, 1996–2012.
5. ГПНТБ СО РАН. Электронные каталоги и базы данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.spsl.nsc.ru/cgi-bin/WWWSearch.cgi>. – Загл. с экрана.
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru. – Загл. с экрана.
7. Научные и учебно-методические публикации : (библиогр. указ.) = Research publications and teaching materials (Bibliography) / Новосиб. гос. техн. ун-т ; отв. ред.: В. Н. Удотова, Т. В. Баздырева. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 1983–2009.
8. Распределенный каталог Новосибирской библиотечной корпорации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://z3950.uiggm.nsc.ru:210/zgw/corp/htm>. – Загл. с экрана.
9. Российская государственная библиотека. Электронный каталог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/index.php?f=339>. – Загл. с экрана.
10. Российская национальная библиотека. Электронный каталог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nlr.ru/poisk/>. – Загл. с экрана.
11. Центр информатизации университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nstu.ru/phone/persons>. – Загл. с экрана.
12. Google [Электронный ресурс] : информ.-поисковая система. – Режим доступа: <http://www.google.ru>. – Загл. с экрана.
13. VTLS Library Catalog. Электронный каталог НБ НГТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://virtua.library.nstu.ru:8000/cgi-bin/gw_46_7/chameleon/. – Загл. с экрана.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ | 3 |
| КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА | 4 |
| Научные публикации..... | 7 |
| Книги, диссертации, авторефераты диссертаций..... | 7 |
| Статьи из периодических изданий и научных сборников..... | 7 |
| Информационные листы, депонированные рукописи | 15 |
| Доклады, тезисы докладов на научных мероприятиях..... | 16 |
| Авторские свидетельства, патенты | 19 |
| Отчеты о НИР | 21 |
| ПУБЛИКАЦИИ О В. Ю. Васильеве..... | 21 |
| ЦИТИРОВАНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В. Ю. Васильева..... | 22 |
| ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ | 26 |
| СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ..... | 27 |

ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

ЮБИЛЕЙНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Книги, статьи и другие работы за 1976–2013 гг.

Ответственные редакторы: *В.Н. Удотова, Т.В. Баздырева, Л.Б. Кистюнина*

Выпускающий редактор *И.П. Брованова*
Корректор *Л.Н. Кинит*
Дизайн обложки *А.В. Ладыжская*
Компьютерная верстка *С.И. Ткачева*

Подписано в печать 24.09.2013. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная
Тираж 50 экз. Уч.-изд. л. 6,51. Печ. л. 3,5. Изд. № 194. Заказ № 873
Цена договорная

Отпечатано в типографии
Новосибирского государственного технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20